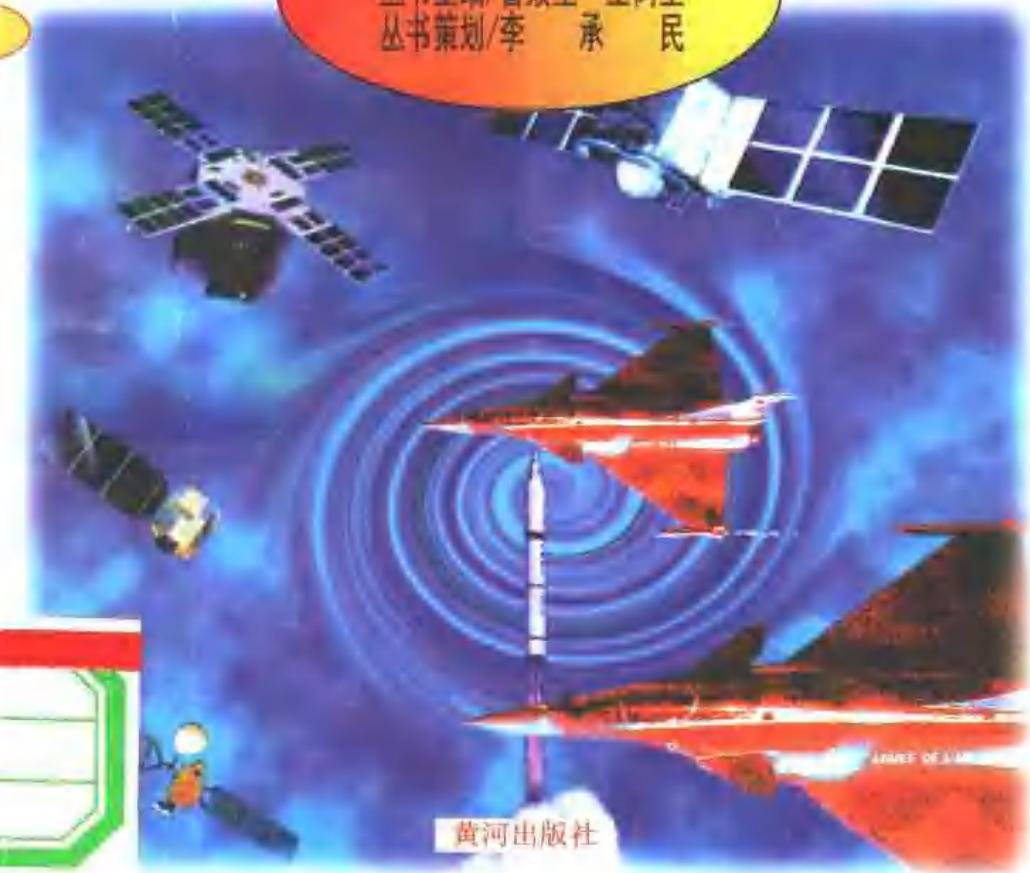


——未来军事家丛书·第19卷——

军用高技术 与新军事革命

本卷编著/王保存
丛书主编/曹效生 王树生
丛书策划/李承民



黄河出版社

未来军事家丛书

曹效生 王树生 主编
李承民 策划

第 19 卷

军用高技术与新军事革命

王保存 编著

黄河出版社

责任编辑 李玉专 李承民
封面设计 金 马 张宪峰

丛书书名 未来军事家丛书
丛书主编 曹效生 王树生
丛书策划 李承民
本卷书名 军用高技术与新军事革命
本卷编著 王保存
出版发行 黄河出版社

(济南市英雄山路 19 号 250002)

印刷装订 章丘市印刷厂
规 格 787×1092 毫米 32 开本
印 张 200 印张 4000 千字
版 次 1997 年 12 月第 1 版
印 次 1997 年 12 月第 1 次印刷
印 数 1—10000 套
书 号 ISBN 7—80558—855—4/E · 150
定 价 260 元(全 40 卷)

总序

正阔步向社会主义现代化强国迈进的中国，需要和平稳定的内外环境。

和平稳定的内外环境，需要强大的人民军队来创造和维护。

强大的人民军队，需要一大批军事家来领导和指挥。

未来的军事家，需要从今天开始培育。

在伟大的中国人民解放军诞辰 70 周年之际，在新世纪的大门即将叩响之时，我们向军内外青少年朋友隆重推介、真诚奉献这部由 40 个分册组成的《未来军事家丛书》。该书的作者都是我国最高军事科研机构的专业研究人员，资料来源全是最新鲜的信息和最原始的档案，由此决定了该书的权威性、全面性、准确性和时代性。我们希望该书的出版能为所有爱好军事、立志报国、血气方刚的青少年朋友提供一个“纸上谈兵”的机会，我们欣喜该书的出版能为全社会的国防教育尽一份微薄之力，我们坚信未来的军事家定将从本书的读者中产生！

编者

前　　言

当前,人类社会正处于世纪之交、千年之交、冷战时代向后冷战时代过渡、工业时代向信息时代转变的千载难逢的伟大历史时刻。此时此刻,五洲激荡,风云变幻,人类面临着时代的严峻挑战。

这挑战,来自本世纪中叶世界大战后平静水面溅起的朵朵高技术浪花。目前,这些涓小的浪花已汇成汹涌澎湃、排山倒海的高技术浪潮,向我们滚滚涌来,猛烈地冲击着人类社会的各个方面,特别是军事领域。自本世纪 60 年代以来,一件件高技术兵器悄然诞生,如今已形成效能神奇的高技术装备家族。自 80 年代以来,一场场高技术条件下的局部战争相继爆发,战争形态逐渐发生巨大而深刻的变化。90 年代初,一场具有鲜明的信息时代特色的战争——海湾战争横空出世。它像一个突然开启的巨大闸门,使新军事革命的洪流以雷霆万钧之势向人类社会汹涌扑来,荡涤着军事领域的方方面面。这次刚刚开始的军事革命,是人类历史上最波澜壮阔的一次。在这场军事革命的大舞台上,将上演一幕幕神奇精彩得令人目不暇接的戏剧。

挑战紧逼,机遇难求,生我逢时,时不我待。我国有抱负、有志向的青少年,一定要关注军用高技术的发展和新军事革命的进程,以便为保卫祖国、固我长城做好准备。

本书分为两篇:上篇——军用高技术篇;下篇——新军事

革命篇。上篇用通俗易懂的语言论述了军用高技术的一般情况和九项具体军用高技术,谈到了它们的由来、沿革与发展,实质与特点,特别是在军事上的应用和对武器装备发展的影响。下篇全面介绍了新军事革命的产生背景、主要内容和基本特点,详细讲解了新军事革命的三大支柱——信息战、数字化部队和数字化战场。上篇与下篇,相互呼应,互为因果。军用高技术的发展,必然引起新军事革命;新军事革命的发生与发展,又会给军用高技术的进步带来强大动力。

军用高技术和新军事革命是一个色彩纷呈、变幻莫测的“万花筒”。本书作者愿与广大读者一道,紧紧跟随时的步伐,不断学习,志在必得,牢记使命,警钟长鸣,继续探索这个“万花筒”的奥秘。

编 者

1996年12月于北京

目 录

前 言 (1)

上篇：军用高技术

- 一、蓬勃发展的高技术与军用高技术 (1)
- 二、“点石成金”的军用微电子技术 (5)
- 三、神通广大的军用计算机技术 (14)
- 四、光彩夺目的军用光电子技术 (23)
- 五、神乎其神的军用束能技术 (33)
- 六、瞒天过海的军用隐形技术 (41)
- 七、“大闹天宫”的军用航天技术 (50)
- 八、五彩缤纷的军用新材料技术 (61)
- 九、异军突起的纳米技术 (72)
- 十、打开战争迷宫的虚拟现实技术 (82)

下篇：新军事革命

- 十一、奏响新军事革命序曲的海湾战争 (94)
- 十二、新军事革命产生的基本动因 (106)
- 十三、军事技术与武器装备革命 (113)
- 十四、军事理论与军事组织体制革命 (121)
- 十五、信息时代的主导作战样式 (129)
- 十六、世人瞩目的数字化部队 (136)
- 十七、划时代的数字化战场 (143)
- 主要参考资料 (151)

上篇：军用高技术

一、蓬勃发展的高技术与军用高技术

当今的世界正处于高技术迅猛发展的新时代。高技术的发展将改变人类社会的方方面面，特别是军事领域。有志于当未来军事家的青少年必须弄清：什么是高技术？一般高技术与军用高技术有什么关系？军用高技术的特点是什么？

(一) 什么是高技术

“高技术”概念起源于美国建筑界，产生于 1968 年，是从英文“High—Technology”直接翻译过来的。60 年代初期，美国的建筑业蓬勃发展，许多大型建筑物拔地而起。这些建筑物的内部装潢时采用了大量新技术、新工艺、新材料，从而使其显得富丽堂皇、美不胜收。面对这些精美绝伦、格调高雅的建筑物，两位美国女建筑师对世界变化之快感慨万端，于 1968 年合写了一本书，名曰《高格调技术》。这就是高技术概念的源头。

进入 70 年代后，“高技术”一词在美国报刊上频频出现，

并很快传播到西欧和日本，同时高技术的含义也由建筑业逐渐扩展到其他领域。人们开始把那些能带来巨大经济效益，能向经济、军事、社会等各个领域广泛渗透的新兴技术产业称为“高技术产业”，把采用新兴技术生产的产品称做“高技术产品”。

到了 80 年代，“高技术”概念被更多的人所接受，“高技术”一词更加广泛地流传开来。

我国国防科技界于 1989 年前后组织七十多位专家探讨高技术的定义。多数人认为：高技术是建立在综合科学的研究基础上，处于当代科学前沿的，对发展生产力、促进社会文明、增强国防实力起先导作用的新技术群，是知识、人才和投资密集的新技术群。我国还有学者认为：高技术是指那些在一定历史时期，对人类社会经济、政治、军事等有重大影响，能形成新兴产业，可实现巨大社会效益的新兴技术或尖端技术。从这个意义上讲，也可以把高技术称为高科技、高新技术或尖端技术。

(二) 军用高技术的发展

军事高技术是一般高技术的重要组成部分，是用于军事领域的那部分高技术，在各领域的高技术中占有特殊的地位。从一定意义上讲，可把高技术分为民用高技术和军用高技术。这两者的关系是：既彼此联系，又相互区别；既各有侧重，又相互渗透；既彼此竞争，又相互促进。

现代军用高技术自从本世纪中叶产生以来大致经历了三个阶段。第一个阶段是从本世纪 50 年代至 70 年代中期的初始阶段。在这二三十年间，以航天技术和计算机技术为先导的

高技术群,首先应用于军事领域。为研制先进武器系统而制造的大型计算机,对美国建立北美防御体系做出了贡献。军用航天飞行器首先用于军事侦察目的。在这一阶段,军用高技术的开发具有探索性的特点,从事研究工作的是个体或小集体,研究周期长,所获成果少。即使如此,这些成果在军事领域所显示的效能也令人震惊。50年代美国在加利福尼亚硅谷中建立的航天与导弹研究基地生产的航空兵器和精确制导武器,在海湾战争中发挥的作用震撼了世界。

第二个阶段是从70年代中期到80年代末期的大发展阶段。在这一阶段,军用微电子技术和军用计算机技术有了长足发展,不仅为一些发达国家建立先进的武器系统创造了条件,也为精确制导武器、智能武器、军用航天飞行系统的研制提供了技术保障。这一时期的军用高技术研究具有广泛性、超前性、协同性、向民用技术渗透的特点。

从80年代至今是第三阶段,而且这一阶段还要持续很长时间。由于国际形势的缓和和新技术革命的深入发展,这一阶段将是军用高技术和民用高技术相互作用、相互转化的重要时期。这一时期,军用高技术的发展速度将放慢,民用高技术的发展速度将加快;最近几年军用高技术将大量向民用技术渗透,此后民用高技术将向军用高技术渗透,带动军用高技术的发展。

军用高技术具有10个重要特性:(1)综合性——各项军用高技术都是由多种技术组成的,是一个个技术群体。(2)渗透性——军用高技术的应用不仅遍及整个军事领域,同时还会迅速转为民用。(3)创新性——军用高技术的科技成果具有生命周期短、创新快的特点,同时它还可在军事领域中支援各

种创新活动。(4)增效性——军用高技术会使武器装备的效能大大提高,使部队的战斗能力增强。(5)时效性——军用高技术发展很快,其阶段性成果只有及时应用与推广,才能发挥巨大的军事效益。(6)智能性——能提高武器系统的自动化和智能化水平。(7)竞争性——各国军队为了走精兵高效之路,竞相发展军用高技术。(8)风险性——军用高技术是前沿技术,要进行超前性研究,其结果难以预料。(9)知识性——军用高技术是以各种科技知识为基础的,其发展更离不开掌握各种知识的高科技人才。(10)战略性——发展军用高技术是国家的战略决策,它直接关系到一国在世界战略格局中的地位。

二、“点石成金”的军用微电子技术

随着以信息技术为龙头的高技术群的迅速发展，人类世界发生了翻天覆地的变化。在这万紫千红的军用高技术百花园中，有一鹤立鸡群、引人注目的奇葩。它就像一只“点石成金”的魔指，使古老的传统军事科技焕发青春，飞速发展，日新月异。它就是当代军用信息技术的基础——军用微电子技术。军用微电子技术对军事技术和军事装备的发展，起着“火车头”的作用，其发展速度和规模，已成为衡量一个国家武器装备发展水平的基本标志。

(一) 军用微电子技术的由来与发展

简单地说，军用微电子技术就是一种使军用电子元器件、电子电路和电子设备微型化的技术。它的基础是军用新材料和精细、超精细加工工业技术。军用微电子技术与单纯依靠缩小部件尺寸来达成小型化的传统电子技术有“质”的不同。它是建立在新概念、新结构和新工艺基础上的微型化电子技术，是电子技术与高科技综合发展、相互渗透的产物。通过微电子技术，可利用和控制固体(即半导体)内部电子运动；采用一些非同一般的工艺方法，在一个微小的体积内，制造具有一种或多种功能的完整的集成电路、微电子部件或电子系统。

微电子技术与军用微电子技术是同步发展的。而且，微电

子技术的每一步突破和发展,都首先运用于军事,体现于军用微电子技术的发展与进步。

传统的电子技术的发展是从电子管的发明和应用开始的。1906年,美国物理学家德福列斯特研制成功世界上第一只三极电子管,做到了用电子管来放大和控制电子信息,实现了电子技术的第一次重大突破。到30年代,以电子管为核心的电子技术已经渗入许多应用领域,推动了整个科学技术的发展。40年代,飞机、舰艇、通信、防空和制导武器系统便大量地使用了各种电子设备。为了提高功能,所设计的电子电路日趋复杂,所使用的电子管数量越来越多。例如,在第二次世界大战中使用的早期雷达就装有电子管数百只。这时的电子设备,虽然功能日益完善,但结构复杂,十分笨重,耗电量大,给实际应用带来了诸多不便。而且,电子管数量的增加,必然相应地降低电子装置的可靠性。因此,缩小体积、减轻重量、减少功耗、提高可靠性,便成为亟待解决的问题。

为了解决电子装置的小型化问题,人们又开始研制晶体管。1945年下半年,美国贝尔电话实验室的巴丁和布鲁顿,为加快雷达的硅探测器和探测器的研究工作,在一次试验中发现,用少数载流子注入法可以调节半导体的电导率,随后便研制成第一只晶体三极管的样品。1949年,美国科学家肖克莱研制出第一只面结型三极管。1950年,晶体管便进入工业化生产阶段。这是电子技术的第二次重大突破。晶体管的优点是:质轻体小,坚固耐用,寿命长,功耗低,性能可靠。于是,世界上又掀起了电子设备晶体管化的浪潮。

在50年代,晶体管逐渐取代了电子管,将电子技术的发展推进到一个新阶段。但是,随着时间的推移和社会需求的发

展,特别是军用需求和航天技术的发展,晶体管电子设备仍然显得太大、太笨重,且可靠性不够。于是,人们又寻求小型化的新途径。1958年,美国得克萨斯仪器公司的基尔比工程师成功地开发了第一块集成电路。这种半导体集成电路,虽然只配有几个晶体二极管、三极管和少量的电阻、电容元件,却标志着半导体元器件微型化的开端。1961年,美国开始批量生产半导体集成电路。人们把集成电路的问世称为电子技术的第三次重大突破。

集成电路一经面世,就以惊人的速度发展。1962~1965年,制成了有10~100只晶体管的小规模集成电路。1966年,发展到集成度为100~1000个元件的中规模集成电路。1967~1973年,研制成1000~10万个元件的大规模集成电路。1978年,超大规模集成电路问世,其集成度为10万~100万个元件。从此,电子技术便真正迈入了微电子时代。在短短的16年内,集成度竟提高了万倍以上。这是电子技术的第四次重大突破。

到目前为止,半导体集成电路已经经历了小、中、大和超大等几个发展阶段,并即将进入一个更新的发展时期。过去一个庞大的电子设备的功能,今天只用几块、甚至一块体积很小的电路芯片便可代替。以大规模集成电路为基础的微电子技术,在使电子设备缩小体积、减轻重量、降低成本、节约能耗、提高可靠性等方面发挥了巨大作用,加快了军用电子器材的数字化、多能化、高速化和自动化。现在,军用微电子技术已成为一切军事现代化设备和系统的核心。它不仅是计算机、通信器材、办公和指挥自动化设备发展的“原动力”,也是提高武器装备性能的“魔术师”。总之,军用微电子技术的发展水平,已

成为一个国家军事技术和军事实力的重要标志之一。

(二) 军用微电子技术的基本知识

微电子技术和军用微电子技术,都是在微小的半导体基片上开发、生产和应用大规模集成电路的技术。随着集成度的不断提高,基片上的元件日益增多,元件也就必将越来越小。美国于1977年生产的第一块超大规模集成电路,在30.4平方毫米的基片上集成了13万只晶体管。这相当于在一根头发的横截面上容纳了近40只晶体管。为了使大家了解微电子技术的知识,先讲一下半导体的“特异功能”,再说说集成电路的奥秘。

人们通过长期研究认识到,半导体有一种“特异功能”:其导电能力不仅变动范围大,而且变动量易于控制。例如,单晶硅的导电能力便随温度升高而增大。在2000℃时,它的导电能力比室温下要大几千倍。如果在硅中掺入某种“杂质”,还能极大地改变其导电性质。“杂质”对半导体的影响,与它们的原子结构有关。所有物质都是由原子构成的,而原子又是由原子核和电子构成的。在原子中,电子围绕原子核运动,并各有各的轨道。例如,硅原子核的外面共有14个带负电荷的电子。由于原子是中性的,硅的原子核就带有14个正电荷。这些电子分三层在原子核周围运行。靠核最近的第一层有两个轨道,被两个电子占有;第二层有8个轨道,可容纳8个电子;剩下的4个电子在第三层。这4个电子受核的约束力最小,称为价电子。元素的化学性质、电性质都与价电子相关。当半导体掺入5价元素磷的“杂质”时,由于磷比硅的最外层多一个电子,因

此就会像金属那样导电。人们称这种“杂质”为 N 型杂质，称相应的半导体为 N 型半导体。如果掺入的“杂质”是 3 价元素硼，情况就不同了。硼原子的外层只有 3 个价电子，比硅少 1 个价电子。这相当于每加入一个硼原子，就多出一个能容纳电子的空穴。所以，这种半导体能形成所谓的空穴导电。这种具有空穴导电能力的半导体与相应杂质，分别被叫作 P 型半导体和 P 型杂质。

当把 N 型半导体与 P 型半导体放在一起时，又会出现一种新的情况——单向导电性。众所周知，如果把一滴蓝墨水滴入清水中，就会出现扩散现象。在半导体中也是这样，当 N 型和 P 型半导体接触时，由于 N 型中电子浓度远远高于 P 型，因此它的电子会向 P 型区扩散。同样，P 型区的空穴浓度高，空穴会向 N 型区扩散。这样，在交界面的两侧便出现了由正、负电荷积累而成的空间电荷区和由此而形成的一个内部电场。这个空间电荷区通常被称作 PN 结。如果在 PN 结上加正向电压，则外电压形成的电场与内电场的方向相反，于是内电场被削弱，PN 结中就发生了电子和空穴的流动，即有了电流。当加反向电压时，则没有电流。这样，就形成了 PN 结的单向导电性。

集成电路正是利用了半导体的上述特性，并通过采用平面工艺来实现微型化的。平面工艺是指将印刷技术中的照相制版技术巧妙地用于晶体管和集成电路的制作，在一个工序中同时制作一大批元件。硅集成电路的制造过程一般分为如下三步：第一，首先按比例高倍放大，并绘制出集成电路各晶体管等元件的电极结构分布设计图；然后再利用照相精缩还原的办法，制成原来大小的精密图形掩模版。第二，在准备制

造集成电路的硅晶片上先涂一层不到1微米厚的二氧化硅薄膜，再敷一层抗蚀性强的感光胶。将掩模版贴在上面进行曝光后，显影溶去未感光的胶，使需要加工的部位裸露出二氧化硅。接着，用腐蚀剂消蚀掉裸出的二氧化硅，并将已感光部分的胶全部溶掉。这样就得到了覆盖在晶片上的、与电路图形完全一样的二氧化硅膜图案。第三，按照电路各部分的不同要求，通过裸露的窗口对硅进行掺杂处理，使它们成为一个个符合要求的晶体管或其他元件。最后，用同样的方法，使各个元器件之间实现互联，使之具备既定的电路功能。

(三)军用微电子技术的应用

军用微电子技术用途广泛，作用巨大。所以，美国国防部认为：“无论是现在或未来，微电子技术实际上对美军任何武器系统都有广泛影响。”

1. 在军事通信器材方面。

与民用通信设备相比，军事通信器材有体积小、重量轻、高保真、抗干扰、便于机动、不易损坏、可维修性强等特点。这主要是大量采用超大规模集成电路的结果。微电子技术运用于军事通信后，可使通信设备发生质的飞跃。在没有采用微电子技术时，一部200瓦电台的重量达100～200千克。同样一部电台，80%的元件采用集成电路后，体积只有原来的 $\frac{1}{3}$ ，重量减少60%以上，性能也大大提高。一部大通路载波机，其大部分元件采用集成电路后，体积可缩小至原来的 $1/10$ ，重量不到原来的 $1/8$ 。数码电报机集成化后，不但体积小，重量轻，更重要的是通报速度大大加快，错码率大幅度降低。程控自动